

CURRICULUM VITAE

Etat civil:

- Nom: **MERZOUGUI**
- Prénom: **AMINA**
- Date et lieu de naissance: **21 AVRIL 1975. CONSTANTINE.**
- Adresse: **86 RUE SAID BENTCHICOU. CONSTANTINE.**
- Code postal: **25000.**
- Nationalité: **ALGERIENNE**
- Sexe: **FEMININ.**
- Nombre d'enfants: **UNE FILLE.**
- Institution: Département d'Electronique, Faculté des sciences et de technologie. Université Mentouri, Constantine 1.
- Laboratoire de recherche : Hyperfréquences et semi-conducteurs: **LHS,**
- Mobile: **0771 13 41 83.**
- E-mail: merzougui3amina@yahoo.fr

Diplômes obtenus:

- **Bac** sciences. session juin **1993**, Constantine.
- **Ingénieur** d'état en **Electronique**, option **Instrumentation**, Intitulé: " Etude des défauts induits par la gravure du polysilicium dans le cas d'un transistor BICMOS". Promotion **1999**. Institut d'électronique, Université de Constantine.
- **DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies)** en **Electronique**, option : Micro-électronique, Institut d'électronique, Université de Constantine. session Juin, 2002
- **Magister** en **Electronique**, option: **Composants**, Intitulé: " Etude des effets quantiques dans les structures MOS à oxyde très mince". Mention: **Bien**, promotion Novembre **2004**, Département d'électronique, Faculté des sciences de l'ingénieur, Université de Mentouri, Constantine.
- **Doctorat** en Sciences en **Electronique**, option: **Composants**, Intitulé: " Etude des courants de fuite de type SILC dans les cellules EEPROMs". Mention: **Très honorable**, promotion Juillet 2010, Département d'électronique, Faculté des sciences de l'ingénieur, Université de Mentouri, Constantine.

Communications internationales (Après doctorat) :

[1] **A. Merzougui**, S. Latrèche, S. Bouchekouf, « Etude des caractéristiques C (V) de capacités à base d'oxydes high-k et semi-conducteurs à forte mobilité. », Deuxième Congrès International sur les Nouveaux Matériaux et les Composants Actifs, Oum el Bouaghi, Algérie, 25, 26 Juin, 2014.

[2] S, Boucekouf, M, Marir, **A. Merzougui**, F, Kebaili, « Modélisation du photocourant dans la cellule organique », Deuxième Congrès International sur les Nouveaux Matériaux et les Composants Actifs, Oum el Bouaghi, Algérie, 25, 26 Juin, 2014.

[3] **A. Merzougui** , S. Latreche , S. Boucekouf, « Simulation of Capacitance-Voltage C (V) and Current- Voltages I(V) characteristics of a MOS capacity with double and tri-layer high permittivity gate oxide», International Electrical & Electronics Engineering and Technologies conferences ELECTROTECH'15, Istanbul, Turkey, October 2-3, 2015.

[4] **A. Merzougui** , S. Latreche , S. Boucekouf , M. Zaabat, « Intérêt des oxydes à fortes permittivités dans les structures MOS: Analyse des caractéristiques C(V) et I(V) », 2^{ème} Conférence Internationale de l'Electronique, Electrotechnique, Automatique et de Maintenance CIEEAM 2015, Oran, 24 - 25 Novembre 2015.

[5] **A. Merzougui** , S. Latreche , M. Zaabat, « Influence of interface states in MOS structures: Analysis of Capacitance-Voltage characteristics », **International conference on advanced material technologies (ICAMT)**, India, 27 - 28 December 2016.

Publication (Après Doctorat) :

[1] **A. Merzougui**, S. Latrèche, S, Boucekouf, « Etude des caractéristiques C (V) de capacités à base d'oxydes high-k et semi-conducteurs à forte mobilité. », Journal of new technology and materials (JNTM). Vol : 5, N° :1, Juin 2015.

[2] S, Boucekouf, M, Marir, **A. Merzougui**, F, Kebaili, « Modélisation du photocourant dans la cellule organique », Journal of new technology and materials (JNTM) Vol : 4, N° :2, Décembre 2014.

Expérience professionnelle (après recrutement) :

Intitulé du module enseigné	Nature Cour/TD/TP	Cycle	Année universitaire
Physique 1	TD et TP	1 ^{ère} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2011 / 2012
Physique 2	TD et TP	1 ^{ère} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2011 / 2012
Physique 3	TD	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016
Informatique 1	TD	1 ^{ère} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2011 / 2012 2012 / 2013
Electronique Fondamentale 1	Cours et TD	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2014 / 2015 2015 / 2016
Electrotechnique 2	TP	2 ^{ème} Année Tronc	2011 / 2012

		commun Sciences et technique (ST)	
Régulation des procédés	Cours et TD	Master 1 : Génie des procédés	2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016
Méthodes numériques	Cours et TD	3 ^{ème} Année : Licence Génie des procédés	2012 / 2013
Caractérisation des composants semi-conducteurs	TP	Master 1 : Electronique	2013 / 2014
Fonctions d'électronique	TP	3 ^{ème} Année : Licence Electronique	2013 / 2014
Technologie de fabrication des circuits intégrés	Cours découverte	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2015 / 2016
Electricité	Cours découverte	2 ^{ème} Année Tronc commun Sciences et technique (ST)	2012 / 2013
Capteurs et Conditionneurs	Cours, TD et TP	2 ^{ème} Année Licence : Mesures physiques	2016 / 2017
Optique Ondulatoire et Photonique	Cours, TD et TP	2 ^{ème} Année Licence : Mesures physiques	2016 / 2017

Polycopié édité:

- **Cours " d'Electronique Fondamentale 1"** destine aux étudiants de **2^{ème} Année Licence** « Mesures physiques », institut de technologie, faculté des Sciences et Sciences de la nature.

Encadrement:

- Master en Electronique, Option: Micro-électronique." ***Influence des effets quantiques sur les caractéristiques C (V) d'une capacité à oxyde ultra mince: Mise en évidence des oxydes à haute permittivité***".
- Master en Electronique, Option: Micro-électronique." : ***Etude des phénomènes de transport à travers des oxydes ultra minces.***".
- Master en Electronique, Option: Micro-électronique." : ***Etude du phénomène de déplétion de la grille en poly(Si) : Analyse des caractéristiques C(V) »***.
- Master en Electronique, Option: Micro-électronique." : ***Etude de l'influence des états d'interface dans les structures MOS à oxyde ultra-mince***».
- Master en Electronique, Option: Micro-électronique." : ***Influence de la température sur le comportement des composants MOS***».
- Master en Electronique, Option: Micro-électronique." : ***Initiation à l'utilisation du logiciel COMSOL : Application à la structure MOS***».